

半导体学报

第4卷 第4期 1983年7月

目 录

- 半导体表面附近施主原子电离能计算.....刘振鹏 (313)
- Gunn 器件中畴的静止-渡越-静止模式的实验观察和计算机模拟
-王守武 郑一阳 郝小林 张进昌 (321)
- 掩膜层生长导致 n-GaAs 表面化学组分的变化对微波器件性能的影响
-陈克铭 王 森 陈维德 方浦明 (334)
- JFET-双极高速宽带运算放大器的设计问题
-易明铤 (340)
- 10 GHz CW GaAs Gunn 器件振荡特性的计算机模拟
-王颖娴 李元垠 潘国雄 (351)
- 二维非等温的分布晶体管模型.....高光渤 吴武臣 (361)
- 短沟道 GaAs MESFET 中的速度过冲效应
-冯育坤 (369)
- 硼离子注入硅的剖面分布.....李国辉 王兴民 卢志恒 张通和 田淑芸 (374)
- 用光注入电流衰减测量绝缘膜中陷阱的俘获截面.....史常忻 顾为芳 (383)

研究简报

- 高纯 VPE-GaAs、LPE-GaAs 的电学性质.....徐寿定 李瑞云 (389)
- LPE-GaAs 表面形成弯月线原因的探讨.....周伯骏 吴让元 (395)
- 铝-硅和金-硅的接触电势差.....陆德仁 (399)
- Si(100) 清洁表面吸附氢的功函数变化.....陈炳来 庄承群 王 迅 (403)
- InSb 液相外延层内的两类层错.....俞振中 马可军 金 刚 (407)
- GD a-Si:(Cl, H) 薄膜的光学性质
-廖显伯 杨喜荣 徐学敏 刘昌灵 孔光临 (410)

本刊第4卷第2期勘误

页	行	误	正
133	13	氢	氟
163	倒9	ϵ_0	δ_0
163	倒8	ϵ	δ